Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0402U002822

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 08-10-2002

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Комаров Микола Вікторович
2. Komarov Nikolay Victorovich

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: кандидат наук

Аспірантура/Докторантура: ні

Шифр наукової спеціальності: 05.02.01

Назва наукової спеціальності: Матеріалознавство

Галузь / галузі знань: Не застосовується

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: Не застосовується

Дата захисту: 03-07-2002

Спеціальність за освітою: 2016

Місце роботи здобувача: ТОВ ПТФ "В-Д-О"

Код за ЄДРПОУ: 21765646

Місцезнаходження: 91005, м. Луганськ, вул.. Градусова, 12

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): Д 64.169.01

Повне найменування юридичної особи: Інститут монокристалів НАН України

Код за ЄДРПОУ: 00210217

Місцезнаходження: просп. Науки, 60, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61072, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

IV. Відомості про підприємство, установу, організацію, в якій було виконано дисертацію

Повне найменування юридичної особи: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Код за ЄДРПОУ: 02070714

Місцезнаходження: просп. Центральний, 59А, м. Сєвєродонецьк, Луганська обл., 93406

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації:

Коди тематичних рубрик: 31.17.39

Тема дисертації:

1. Вирощування легованих монокристалів InSb і моделювання конвекції в розплаві при впливі ультразвуку

2. The growth of doped InSb single crystals and the convection modeling in the melt under ultrasound influence

Реферат/анотація:

1. . Об'єкт дослідження - шарувата неоднорідність домишок, що виникає при вирощуванні монокристалів напівпровідникових матеріалів, мета дослідження - в розробці способу зниження шаруватості при вирощуванні монокристалів InSb методом Чохральського, легованих телуром. Методи дослідження: модифікований метод Чохральського; метод хімічного травлення, оптична й електронна мікроскопія; метод "світлового ножа" із застосуванням відеозапису і комп'ютерної обробки результатів експериментів. Теоретичні та практичні результати, новизна: розроблен спосіб вирощування монокристалів напівпровідників в ультразвуковому полі. Показано, що вплів ультразвуку з частотою від 0,6 до 5,0 МГц усуває шаруватість у області "грані". Ступінь упровадження: запропонований спосіб вирощування кристалів застосовано для росту монокристалів GaAs і Bi-Sb. Сфера використання: технологія напівпровідникових матеріалів.

2. Object of investigation - the dopant striations, which appear in growing semiconductors single crystals, aim of investigation - the develop of the striations decrease method in growing InSb single crystals Te doping by Czochralski method. Methods of investigation: the modified Czochralski method, the method of chemical etching, the optical and electronic microscope, "light cut" method. Theoretical and practical results: The method growing semiconductor in ultrasonic field was developed. The introduction of ultrasonics at a frequency from 0.6 to 5 MHz decreases the striations in the facet. Degree of inculcation: The proposal method of crystal growth used for growing GaAs and Bi-Sb single crystals. Field of application: technology of semiconductors materials.

Державний реєстраційний номер ДіР:

Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки:

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:

Підсумки дослідження:

Публікації:

Наукова (науково-технічна) продукція:

Соціально-економічна спрямованість:

Охоронні документи на ОПІВ:

Впровадження результатів дисертації:

Зв'язок з науковими темами:

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Кожемякін Г. М.
2. Kozhemyakin G. M.

Кваліфікація: д.т.н., 05.02.01

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Офіційні опоненти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Литвинов Л.А.

2. Литвинов Л.А.

Кваліфікація: д.т.н., 01.04.07

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Кутній В.Є.

2. Кутній В.Є.

Кваліфікація: к.т.н., 05.16.01

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Рецензенти

VIII. Заключні відомості

Власне Прізвище Ім'я По-батькові голови ради Толмачов О.В.

Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні Толмачов О.В.

Відповідальний за підготовку облікових документів

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності



Юрченко Т.А.